

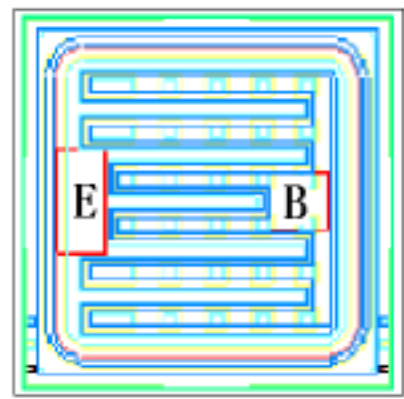


649A 晶体管芯片说明书

芯片简介

芯片尺寸：4 英寸 (100mm)
 芯片代码：A080BJ-00
 芯片厚度：240±20μm
 管芯尺寸：800×800μm²
 焊位尺寸：B 极 124×124μm²；E 极 221×110μm²
 电极金属：铝
 背面金属：金
 典型封装：2SB649A，HS649A，H649A

管芯示意图



极限值 (T_a=25) (TO-126、TO-126ML)

T_{stg}——贮存温度.....-55~150
 T_j——结温..... 150
 P_C——集电极功率耗散 (T_c=25) 20W
 P_C——集电极功率耗散 (T_A=25)1W
 V_{CBO}——集电极—基极电压.....-180V
 V_{CEO}——集电极—发射极电压.....-160V
 V_{EBO}——发射极—基极电压.....-5V
 I_C——集电极电流.....-1.5A

电参数 (T_a=25) (TO-126、TO-126ML)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
BV _{CBO}	集电极—基极击穿电压	-180			V	I _C =-1mA, I _E =0
BV _{CEO}	集电极—发射极击穿电压	-160			V	I _C =-10mA, I _B =0
BV _{EBO}	发射极—基极击穿电压	-5			V	I _E =-1mA, I _C =0
I _{CBO}	集电极—基极截止电流			-10	μA	V _{CB} =-160V, I _E =0
h _{FE}	直流电流增益	60		300		V _{CE} =-5V, I _C =-150mA
		30				V _{CE} =-5V, I _C =-500mA
V _{CE(sat)}	集电极—发射极饱和电压			-1	V	I _C =-500mA, I _B =-50mA
V _{BE}	基极—发射极电压			-1.5	V	V _{CE} =-5V, I _C =-150mA
f _T	特征频率		140		MHz	V _{CE} =-5V, I _C =-150mA
C _{ob}	共基极输出电容		27		pF	V _{CB} =-10V, I _E =0, f=1MHz